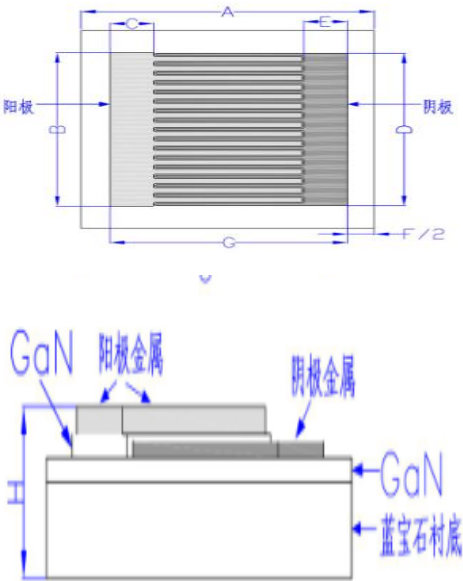


GaN 肖特基二极管芯片 -GJ79SBDA

一、产品特点：

**XG79SBDA**是一款用于电路整流的器件，其耐高温及耐高压性能优于硅肖特基二极管。

二、示意图和尺寸



项目	尺寸	
	mil	um
芯粒尺寸（A）	79±2	2000±50
阳极焊盘长（B）	61±1	1540±25
阳极焊盘宽（C）	12±0.5	300±12
阴极焊盘长（D）	60±1	1500±25
阴极焊盘宽（E）	12±0.5	300±12
切割道宽度（F）	20±0.5	508±12
阴阳极长（G）	64±1	1620±25
芯粒厚度（H）	6±0.5	150±12
其他		
外延材料	GaN	
衬底材料	蓝宝石	
阳极金属	铝	
阴极金属	铝	

三、电性参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
反向电压@-100uA	Vr	-	-	180	V
正向压降@1A	Vf	-	0.7	1.1	V
正向整流电流	Io	-	-	2	A
储存温度	Tstg	-55	-	150	℃
反向漏电流@-50V	Ir	-	5	50	uA

参数	符号	分档				单位
正向压降@1A	Vf	0.5-0.7	0.7-0.9	0.9-1.1		V
反向电压@-100uA	Vr	20-40	40-60	60-80	80-100	V
		100-120	120-140	140-160	160-180	